

Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
2	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.178		7628
	Prepreg	0.178		7628
3	Cu-Lam	0.36	35	
	Tr-Lam		35	
4	Prepreg	0.178		7628
	Prepreg	0.178		7628
5	Cu+galv.Cu		18+25	
6	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke* 1,47 +/- 10%

Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske* 1,58 +/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 thermostabil, gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Lasersacklöcher [B] (blind Vias)	End-Ø	≥ 100 µm
	Viapad-Ø	≥ 350 µm
Kernbohrungen [C] (buried Vias)	End-Ø	250 µm
	Viapad-Ø	≥ 550 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
Leiterbild galvanisierte Innenanlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 110 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 115 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm

Standard

Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer
Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer

≥ 85 µm
≥ 100 µm